

**关键指标**

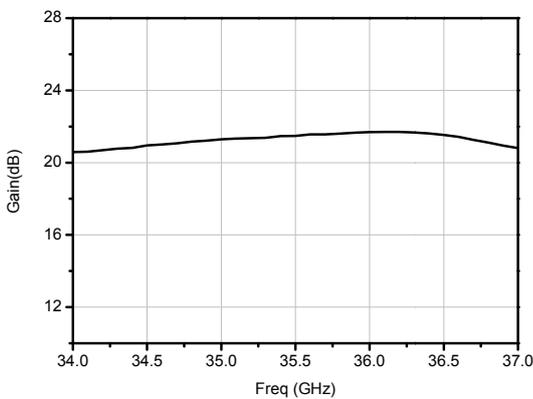
频率: 34~37GHz  
 增益: 21dB  
 1dB 压缩点输出功率: 27dBm  
 功率附加效率: 20%  
 电压/电流: +5V/530mA  
 芯片尺寸: 2.44mm×2.2mm×0.1mm

**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V, V<sub>g</sub>=-1V)**

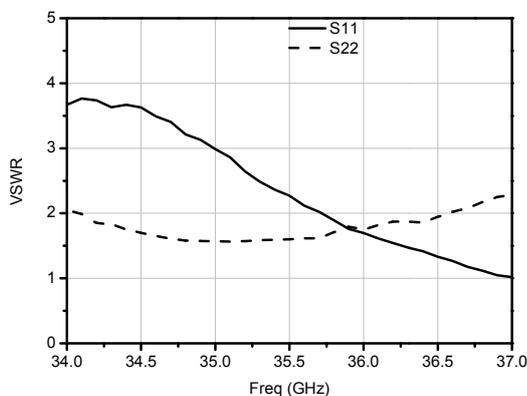
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	34~37		
增益(dB)	-	21	-
增益平坦度(dB)	-	±0.6	-
输入驻波	-	2	-
输出驻波	-	1.8	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	27	-
功率附加效率	-	20%	-
静态电流 (mA)	-	530	-

**典型测试曲线 (V<sub>dd</sub>=+5V)**

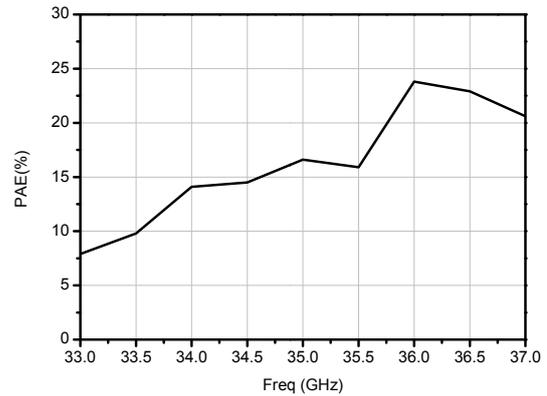
增益



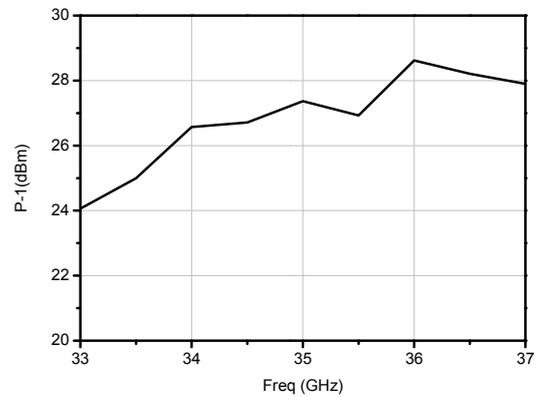
驻波



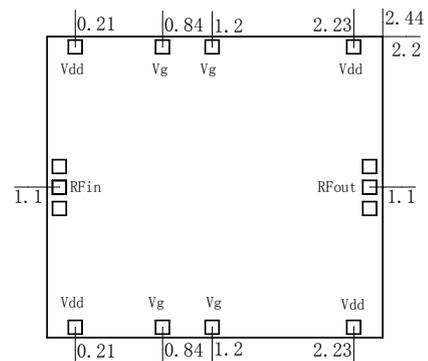
功率附加效率



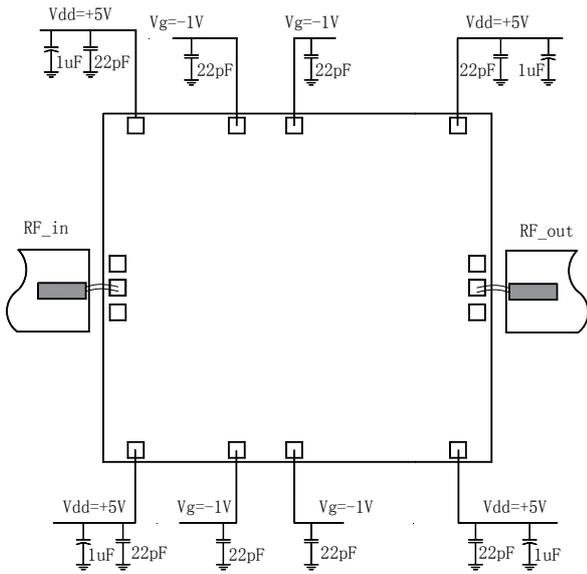
1dB 压缩点输出功率



**外形和端口尺寸 (mm)**



### 推荐装配图



### 绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+25dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。